

Presseinformation

Infineon erweitert Portfolio an Reverse Conducting IGBTs mit 650-V-Klasse – RC-H5 reduziert Schaltverluste um 30 Prozent für eine verbesserte Energieeffizienz

Neubiberg, 15. Mai 2014 – Die Infineon Technologies AG ergänzt die neueste Generation von Reverse Conducting IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistors) für resonante Applikationen um einen 650-V-Baustein mit monolithisch integrierter RC-Diode. Damit gewinnt die leistungsstarke RC-H5-Produktfamilie bei den Anwendungen deutlich an Bandbreite: der neue diskrete Leistungshalbleiter RC-H5 650V eignet sich jetzt auch für den Einsatz etwa in Mehrplatten-Induktionsherden und Inverter-Mikrowellenöfen sowie für alle zum Teil hart schaltenden Halbbrücken-Topologien.

Wie alle RC-H5-Produkte zeichnet sich auch der jetzt vorgestellte diskrete 650-V-Leistungshalbleiter durch eine im Vergleich zu den Vorgänger-Generationen deutlich höhere Energieeffizienz aus. Die Schaltverluste wurden um noch einmal rund 30 Prozent reduziert. Damit ist es Entwicklern möglich, diese neuen Bausteine mit Schaltfrequenzen von bis zu 40 kHz zu verwenden. Das resultiert in einer verbesserten Energieeffizienz, die wiederum zu einer Einsparung der Energieaufnahme von 5 Prozent für das Gesamtsysteme führt.

Neben der herausragenden Energiebilanz arbeiten Systeme auf Basis des RC-H5 650 V auch deutlich zuverlässiger. Die höhere Sperrspannung gibt Entwicklern mehr Flexibilität bei der Design-Auslegung. Auch die Fähigkeit des 650-V-Bausteins, je nach Bedarf weich oder hart zu schalten, schont das Gesamtsystem bei gleichzeitig hoher Einsatzflexibilität. In schnell und weich schaltenden Systemen zahlt sich auch das verbesserte EMI-Verhalten des neuen Bausteins aus, wodurch der Aufwand für Filter reduziert werden kann. Ein optimiertes thermisches Verhalten ermöglicht zudem einen störungsfreien Betrieb bei Umgebungstemperaturen von bis zu 175 Grad Celsius.

„Induktionskochen birgt ein enormes Potenzial, im Bereich der Haushaltsgeräte Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen“, sagt Roland Stele, Marketing Di-

rector IGBT Power Discretes bei Infineon Technologies. „Mit dem diskreten Leistungshalbleiter RC-H5 650 V erweitern wir unser Produktangebot für Haushaltsgeräte und tragen dazu bei, dass unsere Kunden hoch zuverlässige Systeme entwickeln können, die durch einen geringeren Ressourceneinsatz gekennzeichnet sind.“

Portfolio und Verfügbarkeit

Der neue RC-H5-Baustein steht in den Stromklassen 20 A, 40 A und 50 A zur Verfügung. Muster werden von Juni 2014 an ausgeliefert, im selben Monat beginnt auch die Serienproduktion. Optimale Ergebnisse erzielt die RC-H5-Familie in Kombination mit den Treiber-ICs EiceDriver™ 1EDL und 2EDL compact sowie mit Mikrocontrollern der XMC 1000/4000-Familie. Weitere Informationen über die diskreten Leistungshalbleiter RC-H5 von Infineon sind erhältlich unter:

www.infineon.com/rch5.

Infineon auf der PCIM 2014

Infineon präsentiert den RC-H5 650 V sowie die anderen Bausteine der Produktfamilie vom 20. bis zum 22. Mai 2014 auf der Fachmesse PCIM in Nürnberg in Halle 9 auf Stand 311. Weitere Informationen zu den Messehighlights sind verfügbar unter www.infineon.com/PCIM2014.

Über Infineon

Die [Infineon](http://www.infineon.com) Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen an, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: [Energieeffizienz](#), [Mobilität](#) sowie [Sicherheit](#). Mit weltweit rund 26.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2013 (Ende September) einen Umsatz von 3,84 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen unter www.infineon.com.

Diese Presseinformation finden Sie unter www.infineon.com/presse.